УДК 544.431.11/539.216.2

## ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И АТОМНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СИСТЕМЕ Cu/Au (АТОМНОЕ СООТНОШЕНИЕ Cu : Au = 3 : 1)

© 2012 г. Е. Т. Моисеенко<sup>1</sup>, Р. Р. Алтунин<sup>1, 2</sup>, С. М. Жарков<sup>1, 2</sup>

E-mail: zharkov@iph.krasn.ru

Проведены электронно-микроскопические in situ исследования процессов твердофазного синтеза и атомного упорядочения в двухслойных нанопленках Cu/Au с атомным соотношением Cu : Au = 3 : 1. Установлено, что процесс твердофазного синтеза начинается при температуре 170°С. При температуре 280°С в пленке формируется атомно-неупорядоченная структура Cu<sub>3</sub>Au (пространственная группа *Fm*-3*m*, с параметром решетки  $a = 3.76 \pm 0.01$  Å). Отжиг в течение 1 ч при температуре 380°С приводит к формированию во всем объеме пленки атомно-упорядоченной сверхструктуры Cu<sub>3</sub>AuI (тип *L*1<sub>2</sub>), пространственная группа *Pm*-3*m*, с параметром решетки  $a = 3.76 \pm 0.01$  Å.

В настоящее время пленки Си и Аи широко применяют в микроэлектронике. В связи с этим изучение процессов твердофазного синтеза и атомного упорядочения в системе Cu-Au представляет значительный научный и практический интерес, так как изменение фазового состава и упорядочение в системе Си-Аи приводит к изменению физических свойств. Несмотря на то что изучение системы Си-Аи началось достаточно давно, до сих пор не до конца понятны механизмы твердофазного синтеза и атомного упорядочения в этой системе. При этом большинство экспериментов проводят либо на порошках размером ~10-100 мкм [1], либо на толстых пленках толщиной ~1-10 мкм [2], и лишь относительно небольшое количество работ посвящено исследованию пленок Си-Аи толщиной ~10-100 нм [3]. В большинстве экспериментов упорядочение в системе Си-Аи достигается путем длительного отжига образцов. Время отжига составляет от одного часа [3] до нескольких сотен часов [1].

Цель настоящей работы — изучение процессов твердофазного синтеза и атомного упорядочения в тонких двухслойных нанопленках Cu/Au (толщина ~50 нм).

Тонкопленочные образцы Cu/Au были получены методом электронно-лучевого напыления в высоком вакууме с помощью высоковакуумной установки MED-020 (Bal-Tec). Базовый вакуум составлял 5 · 10<sup>-5</sup> Па. Пленки получены последовательным напылением слоев золота и меди на подложку. В качестве подложки использовали свежесколотый монокристалл NaCl, находящий-ся при комнатной температуре. Толщину пленок

<sup>1</sup> Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск. в процессе напыления контролировали при помощи кварцевого резонатора. Средняя скорость напыления составляла 0.3 нм/с. В исследованных пленках Cu/Au толщина слоя меди равнялась 32 нм, золота – 16 нм. Толщины слоев золота и меди выбраны так, чтобы атомное соотношение Cu : Au составляло 3 : 1. Структура и элементный состав пленок Cu/Au исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100 (JEOL), оснащенного энергодисперсионным спектрометром Охford Inca x-sight. Содержание меди в исследованных пленочных образцах составляло  $74 \pm 0.5$  ат. %, золота –  $26 \pm 0.5$  ат. %.

На полученных образцах были проведены электронно-микроскопические in situ исследования изменения фазового состава пленок Cu/Au при нагреве. Нагрев пленочных образцов проводился непосредственно в колонне просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100 с помощью специального держателя образцов (Gatan Model 652 Double Tilt Heating Holder), который позволяет проводить контролируемый нагрев образца от комнатной температуры до +1000°С. Пленки Си/Аи нагревали со скоростью от 4 до 300°С/мин от комнатной температуры вплоть до 600°С, так же проводили отжиг при фиксированной температуре (380°С). Одновременно с нагревом регистрировали картины дифракции электронов и синхронно измеряли температуру образца. Расшифровку картин дифракции электронов проводили с использованием программы DigitalMicrograph (Gatan), а также баз данных кристаллических структур: ICDD PDF 4+ [4], Pearson's Databases [5].

В исходном состоянии пленки состояли из кристаллитов размером 10–20 нм (рис. 1*a*). Дифракционные рефлексы на электронограмме (рис. 1*б*), полученной методом микродифракции

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сибирский федеральный университет, Красноярск.





**Рис. 1.** Электронно-микроскопическое изображение (*a*) и картина дифракции электронов (*б*), полученные от пленки Cu/Au, в исходном состоянии.

от области порядка 1 мкм, имеют поликристаллический вид и соответствуют кубическим гранецентрированным решеткам (ГЦК): Си (пространственная группа *Fm*-3*m*, параметр решетки a = 3.62 Å) [6], и, Аи (пространственная группа *Fm*-3*m*, параметр решетки a = 4.08 Å) [7].

В процессе нагрева при температуре 170°С наблюдались первые слабые изменения картин дифракции, полученных от образцов. Началось размытие дифракционных колец, что свидетельствует о начале реакции на границе раздела Си и Аи. При достижении температуры 250–260°С наблюдали полное размытие дифракционных рефлексов на электронограмме (рис. 2*a*).

В ходе дальнейшего нагрева образцов при температуре 280°С на электронограмме наблюдали появление дифракционных рефлексов, соответствующих новой фазе, отличной от фаз чистых Cu и Au [6, 7]. При дальнейшем нагреве образцов до температуры 330°С дифракционные рефлексы новой фазы становились более четкими (рис. 2*б*). В ходе дальнейшего нагрева вплоть до 360°С дифракционная картина оставалась без изменений. Расшифровка электронограммы (рис. 2*б*) показала наличие неупорядоченной ГЦК-решетки (пространственная группа *Fm*-3*m*), с параметром решетки  $a = 3.76 \pm 0.01$  Å, что соответствует фазе Cu<sub>3</sub>Au [8].

Следует отметить, что помимо рефлексов, соответствующих ГЦК-решетке с параметром a == 3.76 Å на электронограмме, уже при температуре 280°С наблюдали сверхструктурный рефлекс с низкой интенсивностью, соответствующий межплоскостному расстоянию  $3.7 \pm 0.1$  Å. Вплоть до температуры 360°С интенсивность этого рефлекса существенно не менялась. При температуре 380°С сверхструктурный рефлекс стал хорошо различим, появились слабые следы еще одного сверхструктурного рефлекса, соответствующего  $2.6 \pm 0.1$  Å. Известно, что атомное упорядочение в сплавах Си–Аи с составом, близким к Си<sub>75</sub>Аи<sub>25</sub>, приводит к формированию фазы Cu<sub>3</sub>AuI, являющейся атомно-упорядоченной сверхструктурой типа  $L1_2$ , пространственная группа *Рт-3m*, параметр решетки a = 3.747 Å [9]. Исходя из предположения, что в исследованных тонкопленочных образцах в результате нагрева началось формирование атомно-упорядоченной сверхструктуры типа *L*1<sub>2</sub>, наблюдаемые рефлексы можно – идентифицировать как сверхструктурные по отношению к атомно-неупорядоченной фазе Си<sub>3</sub>Аи [8]. В этом случае наблюдаемые рефлексы, соответствующие межплоскостным расстояниям:  $3.7 \pm 0.1$  Å и  $2.6 \pm$  $\pm 0.1$  Å, можно идентифицировать как межплоскостные расстояния атомно-упорядоченной фазы Cu<sub>3</sub>AuI:  $d_{100} = 3.747$  Å и  $d_{110} = 2.649$  Å [9].

С целью формирования атомно-упорядоченной сверхструктуры Cu<sub>3</sub>AuI (тип  $L1_2$ ) во всем объеме пленочного образца Cu–Au, нагретого до 380°C, пленки были отожжены при температуре 380°C в течение одного часа. В ходе отжига усилились интенсивности сверхструктурных рефлексов. Расшифровка электронограммы после отжига (рис. 3*a*) показала, что наблюдается полный набор дифракционных рефлексов, соответствующих атомно-упорядоченной сверхструктуре Cu<sub>3</sub>AuI (тип  $L1_2$ ), пространственная группа *Pm*-3*m*, с пара-

## ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И АТОМНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ



0.84 Å (420) Cu3AuI 0.87 Å (331) Cu3AuI 0.94 Å (400) Cu3AuI 1.09 Å (222) Cu3AuI 1.14 Å (311) Cu3AuI 1.26 Å (300) Cu3AuI 1.54 Å (211) Cu3AuI 1.68 Å (210) Cu3AuI 1.88 Å (200) Cu3AuI 2.17 Å (111) Cu3AuI 2.66 Å (110) Cu3AuI 3.76 Å (100) Cu3AuI



a

**Рис. 2.** Картины микродифракции электронов, полученные от пленки Cu/Au, после нагрева до  $T = 260^{\circ}$ C (*a*);  $T = 330^{\circ}$ C (*b*).

метром решетки  $a = 3.76 \pm 0.01$  Å. Полученное значение в пределах ошибки измерений совпадает с данными, полученными дифракцией рентгеновского излучения: пространственная группа *Pm-3m*, параметр решетки a = 3.747 Å [9]. Трехмерная модель атомно-упорядоченной сверхструктуры Cu<sub>3</sub>AuI (тип *L*1<sub>2</sub>) приведена на рис. *3б* [9].

С целью определения температурной стабильности атомно-упорядоченной сверхструктуры

Си<sub>3</sub>AuI образец был нагрет от комнатной температуры до 600°С со скоростью 4°С/мин. При температуре 395°С отмечено начало уменьшения интенсивности сверхструктурных рефлексов. При достижении температуры 420°С сверхструктурные рефлексы на электронограмме стали практически неразличимы, что свидетельствует о переходе атомно-упорядоченной фазы Cu<sub>3</sub>AuI в атомно-неупорядоченную фазу Cu<sub>3</sub>Au.

Рис. 3. Картина микродифракции электронов, получен-

ная от пленки Cu/Au, после отжига при  $T = 380^{\circ}$ C (*a*), и,

модель расположения атомов в атомно-упорядочен-

ной сверхструктуре Cu<sub>3</sub>AuI (тип  $L1_2$ ) (б).

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ том 76 № 10 2012

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00993а), Федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2013" (Государственный контракт № 16.740.11.0470).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Rentenberger C., Karnthaler H.P. // Acta Mater. 2008. V. 56. P. 2526.
- Malis O., Ludwig K.F. // Phys. Rev. B. 1999. V. 60. № 21. P. 14675.
- 3. *Madakson P., Liu J.C.* // J. Appl. Phys. 1990. V. 68. № 5. P. 2121.

- 4. Powder Diffraction File (PDF 4+, 2010), Inorganic Phases, International Center for Diffraction Data, Swarthmore, PA, USA.
- 5. *Villars P., Cenzual K.* Pearson's Crystal Data: Crystal Structure Database for Inorganic Compounds (on CD-ROM), Release 2011/12, ASM International®, Materials Park, Ohio, USA.
- 6. PDF 4+, 2010, card #00-004-0836.
- 7. PDF 4+, 2010, card #00-004-0784.
- 8. Pearson's Crystal Data, card #456565.
- 9. PDF 4+, 2010, card #04-004-4647; Pearson's Crystal Data, card #530029.